

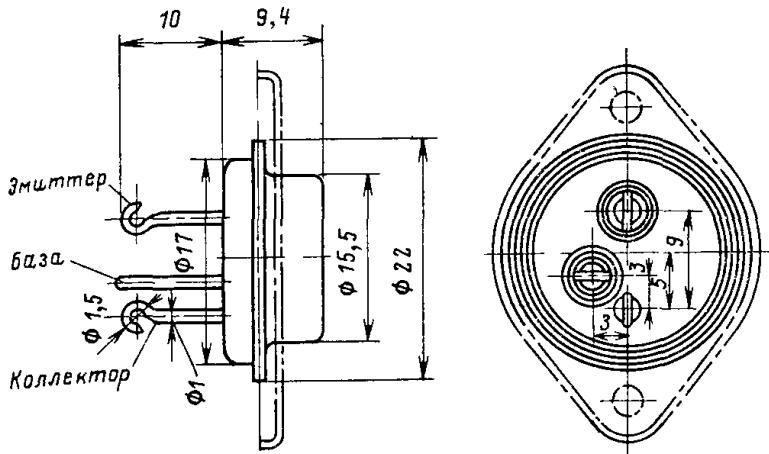
П302, П303, П303А, П304, П306, П306А

Транзисторы кремниевые $p-n-p$ усилительные низкочастотные мощные.

Предназначены для применения в схемах усиления низкой частоты и преобразователях постоянного напряжения.

Выпускаются в металлокорпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 10 г.



Электрические параметры

Сопротивление насыщения коллектор-эмиттер при $I_K =$

$I_b = 150 \text{ mA}$, $I_b = 50 \text{ mA}$ не менее

при $T = 298$ К П303, П303А 20 Ом

при $T = 293$ К и 393, 413 К 26 Ом
при $T = 393$ К и $T = 213$ К П303, П303А 30 Ом

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 10$ В

при $T = 298$ K

при $I_3 = 120$ мА

При $I_2 = 100$ мА П306 при $I_2 = 100$ мА П306

при $I_3 = 100$ мА П306 ; при $I_2 = 60$ мА П304 не менее 5

при $I_3 = 60$ мА П304 не менее : 5
при $I_3 = 50$ мА П306А 5—35

при $T_3 = 30$ мА НЗ00 при $T = 213$ К не меняе-

при $I = 213$ К не менее

при $I_3 = 120$ мА 11303, 11303А 3,1

Материал взят из источника:

Предельная частота коэффициента передачи тока при

$U_{KB} = 20$ В ие менее

при $I_E = 120$ мА

П302	200 кГц
П303, П303А	100 кГц
П304	50 кГц

при $I_E = 100$ мА П306 и при $I_E = 50$ мА П306А 50 кГц

Входное напряжение не более

при $U_{KB} = 10$ В, $I_K = 300$ мА

П302	6 В
П303 П304	10 В
П303А	4 В

при $U_{KB} = 15$ В, $I_K = 300$ мА П306 6 В

при $U_{KB} = 15$ В, $I_K = 200$ мА П306А 4 В

Обратный ток коллектора

при $T = 298$ К $U_{KB} = 35$ В П302, при $U_{KB} = 60$ В

П303, П303А, П304, П306, при $U_{KB} = 80$ В П306А

не более 100 мкА

при $T = 393$ К, $U_{KB} = 30$ В П302, при $U_{KB} =$

= 50 В П303, П303А, П304, П306, при $U_{KB} =$

= 65 В П306А не более 1500 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер

при $T = 298$ К, $R_{BE} = 1$ кОм, $U_{KE} = 40$ В П302,

при $U_{KE} = 70$ В П303, П303А, П306, при $U_{KE} =$

= 100 В П304, П306А не более 1 мА

при $T = 393$ К, $R_{BE} = 100$ Ом, $U_{KE} = 30$ В П302,

при $U_{KE} = 50$ В П303, П303А, П306, при $U_{KE} =$

= 65 В П304, при $U_{KE} = 60$ В П306А не более 6 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{BE} \leq$

≤ 100 Ом и коллектор-база

при $T_n = 213 - 293$ К

П302	30 В
П303, П303А	50 В
П304	65 В

при $T_n = 293 - 373$ К

П302	35 В
П303 П303А, П306	60 В
П304 П306А	80 В

при $T_n = 423$ К

П302	18 В
П303, П303А	30 В
П304	40 В

при $T_n = 298$ К

П306	60 В
П306А	80 В

при $T_n = 213$ К

П306	50 В
П306А	70 В

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

Постоянный ток коллектора		
П306, П306А	0,4 А	
П302, П303, П303А, П304	0,5 А	
Постоянный ток эмиттера П306, П306А	0,5 А	
Постоянный ток базы	0,2 А	
Постоянная рассеиваемая мощность		
с теплоотводом		
при $T_k \leq 323$ К		
П302	7 Вт	
П303, П303А, П304, П306, П306А	10 Вт	
при $T_k = 393$ К		
П302, П303, П303А, П304	1 Вт	
П306, П306А	2 Вт	
при $T_k = 363$ К: П306, П306А	3 Вт	
без теплоотвода		
при $T \leq 323$ К	1 Вт	
при $T = 393$ К	0,3 Вт	
Температура перехода	423 К	
Тепловое сопротивление:		
переход-корпус	10 К/Вт	
переход-среда	100 К/Вт	
Температура окружающей среды	От 213 до 393 К	

Примечания 1. $U_{K\text{Э макс}}$, $U_{K\text{Б макс}}$ при повышении температуры перехода выше 373 К снижаются линейно на 10 % на каждые 10 К. Температура перехода определяется по формуле:

$$T_n = T_k + R_{T_n - k} P_K.$$

2. P_K макс, Вт, с теплоотводом при $T_k > 323$ К определяется по формуле:

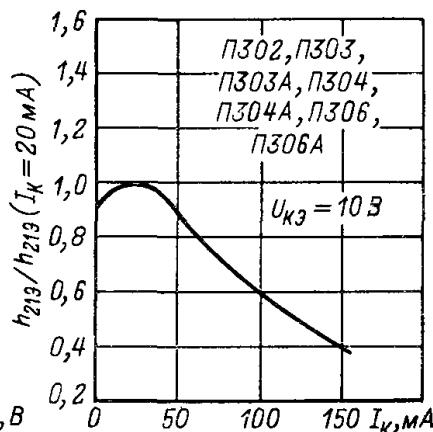
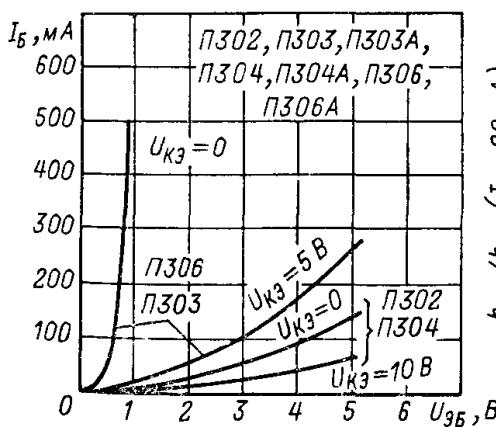
$$P_K \text{ макс} = (423 - T_k) / 10$$

3. P_K макс, Вт, без теплоотвода при $T_k > 323$ К определяется по формуле

$$P_K \text{ макс} = (423 - T) / 100.$$

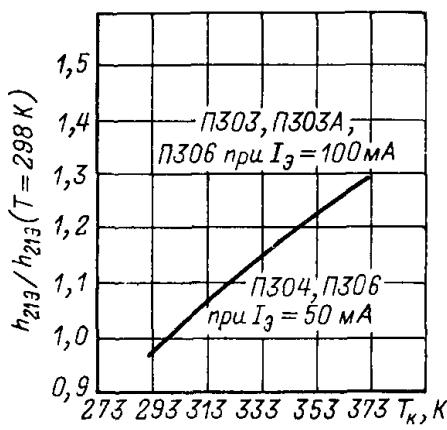
Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985

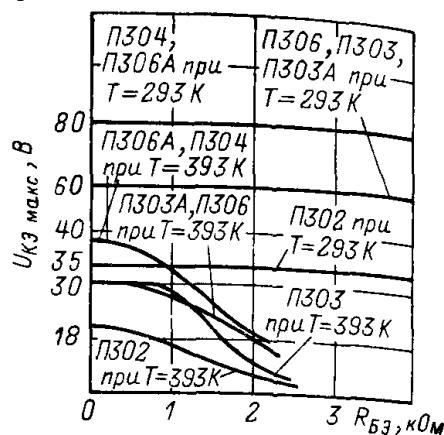


Входные характеристики.

Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса.



Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985